9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⊌公開特許公報(A)

昭60 - 107017

@Int Cl.⁴

機別記号 104 庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)6月12日

G 02 B 26/10

7348-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

母発明の名称 光偏向素子

砂特 瞬 昭58-213927

❷出 顧 昭58(1983)11月16日

日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究 60条 明 辺 Œ Ed 所内 母 発明 Ш 児 者 上 更 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究 所内 伊発 蚏 æ 智 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究 所内 n A 明 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究

所内 砂出 駅 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

20代 理 人 井理士 高橋 明夫 外3名

明 組 哲

発明の名称 光偏向電子

特許請求の範囲

1. 一つの基板図内に形成され、複数の、互いに 運動方向の異なるパネ部と、このパネ部に支持され、互いに拘束されない運動をしりる可動部と、 この可動部に形成される反射鏡と、前配可動部に 形成され、前配可動部を駆動する電気的又は磁気 的手段とからなることを特徴とする先間向業子。

2 特許請求の範囲第1項んかいて、

前記基板が半導体の単純品からなり、前配可動 部は前記基板面上で互いに直交する船を支点とし て二次元の回転提動をするように構成したことを 特数とする光偏向象子。

3. 特許請求の範囲第1項叉は第2項において、

前記可動部を駆動する手段として、前記可動部 上に導電コイルパターンを形成したことを特徴と する光偏向象子。

発明の評価を説明

[発明の利用分野]

本発明は光偏向走売ま子に係り、特に、光を機 械的に偏向走査するガルバノミラーに関する。 [発明の背景]

光偏向走査案子には、従来より、(1)機械式、(3) 批気光学式、及び(8)音響光学式などの種々の方式 があり、ディスプレイやプリンタから光メモリ用 まで各方式の特長を生かした応用が展開されている。

機械式はミラーヤブリズムを回転又は影動させるもので、この程の象子として最も古典的である。 しかし、個向角が大きいため解像点の数が多いこと、先の損失が少ないこと等の利点があり、ディスプレイヤブリンタを中心に未だにこの種の象子の主流をなしている。

回転ミラー方式はモータ回転の高速化と高程度 加工した多面観化より大きい個向角で高速な走金 が可能となつたため、レーザピームブリンタ (LBP) 化実用されている。しかし、この場合 の回転は一次元であるため、二次元走金を行えわ せるには少なくとも二つの回転ミラーを必要とす る。このため、多面質の高程度を加工を必要とする点で回転ミラー自体が高価となる化とどすらず、 個向走査システムも高価なものとなる。

一方・振動さう・・(カルパノミラー) 方式では 並近、半導体プロセスの分野で発達した写真会員 の高稽度加工技術を用いた、小形で高速応答のも のが種々提案されている。 しかし、 これらはすべ て走査方向が一次元であるため、二次元走査を行 なわせるためには、二つの菓子が必要となり、 か つ、それらの走査パランスの調整が重要を技術観 になるため、上記問様個向走査システムとして 高価なものとなる。

(発明の目的)

本発明の目的は一つの菓子で二次元の傷向走査 をなしりるガルパノミラーを提供するにある。

【発明の収表】

本発明はガルパノミラーをジンパルばねて支持 した構造とする点に最大の特徴がある。とのジン パルばねは、例えば、Si 基板の写真会知により 具現化できる。また、ミラーはSi 基板上に金属 無着等により形成する。二次元の偏向走臺は、例えばくう一面に無着又はメッキした事襲コイルに 電流を走した状態で、Y、Yの二方向から磁外を 加え、この磁界を被検出脈に応じてそれぞれ止立 に変化させることにより実現する。以下・実施例 を示して本発明を評細に説明する。

網1回は本発明の原理構造である。

81単結晶からなる基板1を写真食質によりジンパルパネ状に加工する。ジンパルパネ2はX方向軸5を中心値として、それぞれ、独立に回転描かする。ジンパルパネ2で支持された基板1の中央の可動部面上には金銭流着ヤメツキ等によりガルパノミラー3と確実コイル4が形成方向の磁界7及び高を中心をサれば、ま子に変化されたガルパノミラー3に一定方向から光ビームを入射してかけば、元元に偏向できたが大力に変化が表してかけば、元元に偏向できたを検出量に応じて二次に偏向でき

る。即ち、X、Yの二変数をもつ信号量F(X、Y)の変化を一つの男子で検出し、その出力に応じた光の偏向走査ができる。

[発明の実施例]

第2図は上記の原理構造を具現化しりる一実施 例である。

同図において、1は(100)面方位をもつれ 形 3 1 の単語品基板である。基板1は通常のIC 技術の一つである写真会知法及び化学的会知法化 より、支点12-12'及び13-13'をもつ ジンパルパネ構造を形成すべく加工される。かか る会知加工としては、例えば。ミラー3等の形成 される面を耐会性樹脂等の歯布によつ代題をした での裏面をSiO。 膜又は感光性耐食解析を 比のた写真感光法等のパターンニング処理を施え した後、KOH等のアルカリ溶液による異方性退 択エッチングを行なり方法を用いる。

との加工法により、ガルパ果子は固定部(基板 1) と可動部1′に分離される。可動部1′の大 g さはガルパ鬼子の駆動性能化影響を及ぼす。即 ち、可動部 1 ' のギンピング効果を大きくする場合は、可動部 1 ' の表面積を大きくして空気抵抗を大きくすればよい。一方、高速偏向走産を行なわせる場合は、可動部 1 ' の質量を小さくする必要がある。従つて、かかるガルパ以子の用途に応じた設計、例えば、精密計算を指向する場合は平衡型としてダンピング効果等を重視し、ディスプレイ等を指向する場合は慣性影動型として高速走産を重視する等の配慮が肝器である。

かかる可動部の特性速度はガルパ東子の設置される開門の雰囲気によつても影響を受ける。例えば、可動部は真空中にかかれれば極めて高速に幼作し、ある特定粘度の液体中にかかれるととにより、良好なダンピング特性を示す。従つて、動作速度の精密な制御を受ける場合に、ガルパま子周囲の液体の種類及び圧力を最適に調整する必要がある。

ミラー3は、例えば、AR、AL、Au等の基盤 等通常のミラーコーテインク技術、又は、基板1 をそのままミラーポリンジニする方法等により形 成される。かかるミラー形成にあたつては、特に 金属点療法を用いる場合、熱応力によるゆがみが 生じないように、例えば、温板1 との熱態侵係数 是の小さい材料を選択する。点療障膜の厚さを最 最段計する特に智恵する必要がある。また、基板 1 をミラーボリッシュする場合は、最後的歪が残 らないように智念する必要がある。

1 ラー3 自体を干渉フィルタとすれば、任意色の光を反射光として持ちれるため、例えば、平面ディスプレイ等に応用する場合は、カラー化が容易となる。

るためには、可動部11の面積を大きくするか、 又は課電コイル4に印加する電配値を大きくする 必要がある。前者の方法はジンパルパネの応答性 の点で制約があり、後者の方法ではコイルの発熱 等により制約を受ける。この条件を考慮して用途 に応じた最適設計が必要である。

ははコイルもは A 8。A 4。A 2 等の 活着により、 え うーと同時で、且つ、同様の方法で形成される のが望ましい。プロセスが関略化され、歩 旬向上、 コスト低級が固れるからである。しかし、 導電コ イルもは発熱を抑える設点から、低抗を数100 一数1000と小さくする方が良いため、 延療膜 は 厚い方が良い。一方、 ミラー3は前述のとかり、 若被1との熱影強器による歪を抑えるために、 延 着膜は薄い方が良い。かかる状況を考慮して、用 途に応じた最適手法をとる必要がある。

また、導電コイル4は基板1の可動部1、表面上に通常の1C技術の一つである写真を制法でパ ターンを形成される。この膜、基板1と導電コイ ル4とは電気的に絶縁される必要があり、通常は

図示のようにSiO:等の絶触性膜10を形成する。 かかる絶触性膜10もミラー3のゆがみを抑える ために、熱態張係数、厚さ等を十分考慮する必要 がある。

回図にかいて、9は電板パッドであり、基板 (回足部) 1 上に形成される。パッド9は、例え は、A 4 般等を用いたワイヤボンデイング技術に より外部端子と接続され、パッド9を通して導電 コイル4 に電視が印加される。

単価パッド9は導電コイル と同一の材料で同時化、例えば、無着等化より形成されるのが望ましいが必ずしも同一又は同時ということに限定されない。

パッド9の一方は場合コイル4の最外数選が 14と直接会属等の場体を介して最終される。な か、両者を同一材料で同時に形成する場合は、あ らかじめ、写真会超法で両者を連結したパタンニ ングを施とせばよい。また、パッド9の他方は導 はコイル4の最内数強部15と最終される。この 最終は必ず導はコイル4と交差するため、この交 差部分を電気的化絶称する必要がある。本実施例では関示のように、基板1の可由部1' 表面上に 連盟コイル4の強額15と単極ペッドの凝認9' とを電気的に接続する単体層11を選択的ド(この部分のみ)形成し、交差する構成コイル4との 絶縁を前述した510。等の絶縁性膜で行なう。その他の方法には、例えば、交差する場面コイル4をまたぐように、Aと等のワイヤでボンディング 結びしてもよい。 湯体層11は基板1と逆の操作をもつ不能物(例えばボロン等)を選択的に拡発することにより形成される。

なお、かかる拡散技術化より、見板の何色支点 12,12′及び13,13′部分に並続脳を形成しておけば、低抗層は基板可約部1′の回転化 よるねじれ角(せん新ひずみ)に応じて抵抗協会 化するため、本発明の二か元ガルバを子は何時化 角度センサをも乗ねることができる。

第3 頃は本発明の二次元ガルバボ子の固定方法 に関する場場例である。基板(固定部)1は関示のように基体10と無理される。かかる以は10 は、例えば、ホウケイ酸ガラス等の、基板1と熱 膨張係数の近似した材料であり、基板1との延着 は後滑利を全く用いない陽極振着法で行なり。

との方法化よれば、熱化よる残留亜が強めて少なく、消傷の無倉制化よくみられる無僧層の劣化 現象がないため、ミラー3 化ゆがみをもたらする とがなく、延門変化の少い高寿命のガルパ象子を 具現化でまる。

本発明の兼着固定法を用いる場合、必ずしも無 3 図に示す物成に限られない。

指4回は本知明の二次元先偏向余子の応用例について機略を示したものである。本発明の具体的応用例は、レーサビームブリンタ、投射形テレビ、投射形平面デイスブレイ(例えば、液晶デイスブレイ)への普込、光カードメモリ成出・省込等の情報機器・及び電磁オシログラフ等の計画機器がある。いずれの場合も従来一次元偏向常子を複数個用いていたところを本発明の二次元偏向常子一つでまかなえる。従つて、無4回のように一種語言が応える。

また、第1個でX。 Y各方向についてそれぞれ 印加する磁界は、例えば、電磁石によつて形成され、磁界変化は電磁石の電視値を変えるととによ り生じる。一次元方向の回転運動について二方向 以上の電磁函動力を用いると、偏向角度をより大 まくできる。

[発明の効果]

本発明によれば一つのま子で二次元の傷向走査 をなし得る。

図面の簡単な説明

第1回は本発明の原理因、第2回。第3回は本 第5回 発明の一実施例の断面因、第4回は本発明の応用 に関する原理説明図である。

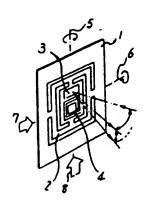
1 … 帯板、3 … ミラー、4 … 導電コイル、10 … 絶縁性膜、11 … 導電槽。

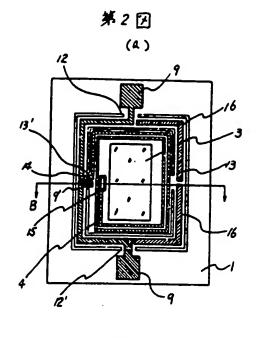
代個人 弁理士 高額明夫

なか、無1型で収明したように、本実施例では ミラー部3を単型力で回転収動しているが、とれ を静電力としても本発明の本質を失うものではな

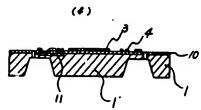
第5回は本発明のガルパネ子を静覚力で彫めす る場合の実施例である。河図化かいて、場体10 はホウケイ酸ガラス等の、当転1と熱彩強係数の 近似した材料からなり。中央化設けた凹部の各辺 KAつて4種が少くとも四箇所111~114K 形成される。又、基体10の凹部中心にはガルバ 米子可動部1′を支持する炎起12が形成される。 智植11は、例えば、蒸着等で容易に形成できる。 凹部及び突起12は選択的化学エツテング等によ り容易に実現できる。可動部1′と電催111, 113との間の計電力による回転援動・及び可動 部1~と単振112。114との間の静心力によ る図転扱動をそれぞれ突起12を中心として独立 化発生させ、との二次元回転掘動を行なり可動部 1 / 上にミラー3を形成することにより、二次元 の光偏向走査が可能となる。

第1区

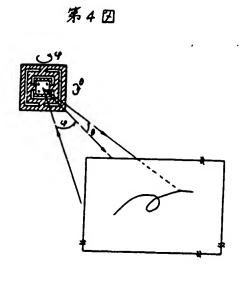


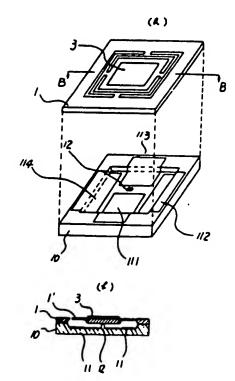












THIS PAGE BLANK (USPTO)